

RFMD 新闻发布



联络方式:

RF Micro Devices Inc.
Brian K. Cockman, 公关专员
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
电话: +1 (336) 678-8945
bcockman@rfmd.com

RFMD® 收到顶级军火商的 GaN 订单

RFMD 的第一份氮化镓 (GaN) 功率放大器订单

RFMD GaN 的战略要点:

- 使 RFMD 的市场及客户实现多样化
- 充分利用 RFMD 在复合半导体及功率放大器方面的专业技能
- 将 RFMD 的总体现有市场拓展 10 亿美元, 而需要涵盖高功率半导体市场

北卡罗来纳州、格林斯伯勒 - 2007 年 1 月 29 日 - 日前, 设计与制造面向可推动移动通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先者 RF Micro Devices, Inc. 公司 (Nasdaq 股市代号: RFMD) 宣布, 该公司已收到来自顶级军火商的第一份新产品订单, RFMD 的新产品采用 RFMD 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 工艺技术。RFMD 的 GaN 技术可在极广泛的微波频率范围内运行, 这使其成为多频带及宽带应用的理想之选。该订单是 RFMD 收到的第一份 GaN 功率放大器订单。

该订单所定的是 RFMD 的 RF3825 型功率集成电路 (PowerIC) 宽带功率放大器, 其功率为 15 瓦、工作频率范围从 200MHz 到 1.9 GHz。RF3825 极大地提高了适用于军用通信的软件定义无线电应用的带宽。

RFMD 总裁兼首席执行官 Bob Bruggeworth 指出: “我们专有 GaN 工艺技术的这第一份订单代表了 RF Micro Devices 在客户及市场多样化方面迈出的重要一步。这些新市场所呈现的总创收商机大约为 10 亿美元, 这对 RFMD 而言意义深远, 并且为我们提供了增加收入、利润及收益的新推动力。我们的 GaN 开发已得到了美国政府的部分资助, GaN 技术特性在众多军事应用中具有出色表现, 此次宣布仅突出了其中的一个应用。此外, GaN 技术还适用于军事领域以外的市场, 其中包括公共移动无线电、WiMAX 及 WCDMA 基站。通过充分利用了我们业界领先的复合半导体制造资源及设计人员的才智, RFMD 已在 GaN 领域取得了公认的领先地位。”

RFMD 首席技术官 Bill Pratt 强调：“GaN 具有独特的电特性，这些特性可使其成为高功率、高性能应用的理想技术。与在许多市场中成为 GaN 主要竞争对手的硅 LDMOS 技术相比，GaN 具有远胜于该技术的效率及功率密度。此外，GaN 技术还能够在极广泛的频率范围内运行。因此，与竞争的同类工艺技术（例如 LDMOS）所需的多个器件相比，GaN 能够凭借一个器件以低成本方式满足 WCDMA、WiMAX、军用通信干扰机及其它市场中的多频带需求。”

RFMD 正在位于北卡罗来纳州、格林斯伯勒的高量产制造机构制造其专有 GaN 技术产品，并计划充分利用 RFMD 在复合半导体方面的专业技能以及在功率放大器方面的领先地位。RFMD 堪称全球领先的 AlGaAs HBT 与 GaAs pHEMT 制造商。该公司还是 InGaP HBT 方面的领先制造商，最近 RFMD 推出了其第二代 InGaP HBT 工艺。RFMD 还是全球领先的蜂窝功率放大器制造商。RFMD 于 2000 年开始致力于 GaN 技术的商业化工作，并期望于 2007 年上半年开始首次产品发运。

RFMD 期望在 2007 年宣布推出采用 GaN 技术的更多未来改进产品，其中包括推出具有高线性、高带宽且功率输出高达 200 瓦的高功率放大器（HPA）。

关于 RFMD：RFMD 堪称设计与制造面向可推动移动通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先者。RFMD 的功率放大器、发送模块、蜂窝收发器及片上系统（SOC）解决方案可实现全球移动性，提供更高的连接能力，以及支持当代及下一代移动手机、蜂窝基站、无线局域网（WLAN）、无线个人区域网络（WPAN）及全球定位系统（GPS）中的高级功能。RFMD 因其多样化的一流半导体技术以及广泛的 RF 系统专业技能而著称，在使全球领先移动终端制造商能够提供可满足当前及未来市场需求的先进无线功能方面，RFMD 为首选供应商。

RFMD 总部位于北卡罗来纳、格林斯伯勒，是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的 ISO 9001 及 ISO 14001 认证制造商。RFMD 在纳斯达克全球市场上市交易，交易代码为 RFMD。有关更多信息，请访问 RFMD 网站：www.rfmd.com。

本新闻稿包含符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条例的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括，但不限于，有关我们计划、目标、陈述及论点的声明，并且并非历史事实，这些声明一般可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“期望”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”及类似措辞的使用加以辨别，尽管有些前瞻性声明是通过不同方式加以表述的。您应了解，本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断及期望，但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性声明所表达或暗示的有重大差异。除联邦证券法所要求的之外，我们不打算更新任何这些前瞻性声明，也不计划公开宣布对这些前瞻性声明的任何修订结果。RF Micro Devices 的业务受多种风险和不确定性因素的影响，包括季度运营结果的易变性；无线市场的成长与发展速率；与以下机构的运营相关的风险：我们的晶圆制造机构、分子束外延机构、我们的装配机构，以及我们的测试、带盘机构；吸引和保留熟练员工及培养领导者的能力；生产良率的易变性；采用新技术以降低成本、提高毛利率的能力；将新产品推向市场的能力；快速调整产能以适应产品需求变化的能力；对有限客户的依赖；对第三方的依赖。在由美国证券交易委员会归档的 RF Micro Devices 10-K 报表的最新年度报告中更详细讨论的这些以及其它风险和不确定性因素，可能导致实际结果和发展与此处任何一个前瞻性声明中明示或暗示的意义存在本质性偏差。

RF MICRO DEVICES® 和 RFMD® 为 RFMD, LLC. 的商标。所有其它商品名称、商标及注册商标归其各自所有者所有。

###